

## 參考文獻

1. J.J. Wierer, D. A Steigerwald, M. R. Krames, J.J. O' Shea, M. J. Ludowise, et al., *Appl. Phys. Lett.*, 78 3379(2001)
2. S. Nakamura, T. Mukai, and M. Senoh, *Appl. Phys. Lett.*, 64, 1687(1997)
3. M. Yoder, *IEEE Trans. Electron Devices* 43,1633(1996)
4. M. Osinski, P. Perlin, P.G. Eliseev, J. Lee, V.A. Smagley, *Journal of Crystal Growth*, 189/190, 803-807(1998)
5. R. Nakasaki, T. Hashizume, H. Hasegawa, *Physica E*, 7, 953(2000)
6. S. Arulkumar, T. Egawa, H. Ishikawa, T. Jimbo, M. Umeno, *Appl. Phys. Lett.*, 73, 809(1998)
7. M. Hong, K. A. Anselm, J. Kwo, H.M. Ng, J. N. Baillargen, A. R. Kortan, J. P. Mannaerts, A. Y. Cho, *J. Vac. Sci Technol, B* 18, 1453(2000)
8. L. W. Tu, W.C. Kuo, Kuo, K.H. Lee, P. H. Taso, C. M. Lai, *Appl. Phys. Lett.*, 77, 3788(2000).
9. C. B. Vartuli, S. J. Pearton, C. R. Abernathy, J. D. MacKenzie, E. S. Lambers, and J. C. Zolper, *J. Vac. Sci. Technol. B* 14, 3523 (1996)
10. J. W. Seo, C. S. Oh, H. S. Jeong, J. W. Yang, a) K. Y. Lim, C. J. Yoon, and H. J. Lee, *Appl. Phys. Lett.* Vol. 81, No. 6, 5, 1029, (2002).
11. T. Rotter, a) D. Mistele, J. Stemmer, F. Fedler, J. Aderhold, and J. Graul *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 76, No. 26, 26 June, 3923, (2000)
12. Dejum Fu, Shavakat U. Yuldashev, Nam Hwa Kim, *JJAP*, Vol. 40, L11(2000) Pt. 2, No. 1 A/B
13. L-H. Peng, a) C.-H. Liao, and Y.-C. Hsu *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 76, No. 4, 24, 511(2000)
14. Yoshitaka Nakano a) and Tetsu Kachi, *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 82, No. 15, 14, 2443, (2003)
15. D. J. Fu, a) T. W. Kang, b) Sh. U. Yuldashev, N. H. Kim, S. H. Park, and J. S. Yun, 1310 *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 78, No. 9, 26 February 2001
16. C. R. Eddy, Jr. and B. Molnar, *J. Electron. Mater.* 28, 314 (1999).
17. R. J. Shul, J. C. Zolper, M. Hagerott Crawford, R. J. Hickman, R. D. Briggs, S. J. Pearton, J. W. Lee, R. F. Karlicek, Jr., C. Tran, M. Schurman, C. Constantine, and C. Barratt, *Proceeding of High Speed III-V Electronics for Wireless Applications/State of the Art Program on Compound Semiconductor (SOTAPOCS) XXV*, San Antonio, TX, 6-11 October(1996)(Electrochemical Society, Pennington, NJ, 1996), p. 232.
18. R. J. Nelson and R. G. Sobers, *J. Appl. Phys.* 49, 6103 (1978).
19. I. Schnitzer, E. Yablonoitch, C. Caneau, and T. J. Gmitter, *Appl. Phys. Lett.* 62, 131 (1993).

20. H. W. Choia) and M. D. Dawson , *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 83, No. 22, 1 4483 ( 2003)
21. H. W. Choi, C. W. Jeon, M. D. Dawson, *Senior Member, IEEE*, P. R. Edwards, and R. W. Martin , *IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS*, VOL. 15, NO. 4, APRIL 510 (2003)
22. S. X. Jin, J. Li, J. Y. Lin, and H. X. Jiang, *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 77, No. 20, 13 November 3236(2000)
23. Schnitzer and E. Yablonovitch, *Appl. Phys. Lett.* 63 (16), 18 ,2174 , (1993)
24. Hadis Morkoc “ Nitride Semiconductors and Devices ” p303
25. 巫漢敏(2002) , 台灣大學光電工程研究所 , 碩士論文
26. L. M. Huygen, K. Strubbe, W. P. Gomes, *Journal of The Electrochemical Society* , 147 ,1797 (2000)
27. J. E. Borton , *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 77, No. 8, 21 ,1228 , (2000)
28. R. Khare, D. B. Young, G. L. Snider, and E. L. Hu , *Appl. Phys. Lett.* 62 (15), 12 ,1809(1993)
29. J. R. Mileham, S. J. Pearton, C. R. Abernathy, and J. D. MacKenzie, *J. Vac. Sci. Technol. A* 14(3), May/Jun , 836 ,(1996)
30. J. R. Mileham, S. J. Pearton, a) C. R. Abernathy, and J. D. MacKenzie, *Appl. Phys. Lett.* 67 (8), 21 August 1119, (1995)